Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук

объявляет конкурс на замещение вакантной должности

научного сотрудника

в лабораторию неравновесных процессов в полупроводниках Вакансия 145805

Тематика исследований

Исследование и анализ электрических и оптических свойств углеродных наноструктур и их композитов с полупроводниковыми полимерами и перовскитами, а также определение их потенциала для использования в оптоэлектронике и других технологических применениях.

Трудовая деятельность

Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в области физики конденсированного состояния, связанных с электронными, фотоэлектронными и оптическими свойствами проводящих полимеров; полимерно-неорганических композитных наночастиц, биополимеров, материалы на основе перовскитов и устройства органической микроэлектроники на основе этих полимерных наноструктур.

- выполнение работ в качестве ответственного исполнителя или совместно с научным руководителем в области изучения новых органических и полимерных полупроводников и материалов на их основе с высокой подвижностью носителей заряда;
- получение новых наногибридных материалов, сочетающие в себе уникальные свойства углеродных и полимерных материалов, а также создание новых устройств на основе этих материалов;
- участие в составлении планов и методологических программ исследований и разработок, практических рекомендаций по использованию результатов; участие во внедрение результатов исследований и разработок;
- подготовка научных публикаций и представление полученных результатов на научных конференциях и семинарах;
- проведение исследований и подготовка отчетов по проектам фундаментальных и прикладных работ в качестве исполнителя;
- подготовка и подача материалов для регистрации результатов интеллектуальной деятельности;
- руководство и обучение студентов фундаментальным и прикладным навыкам проведения исследовательских работ.

Требования к претенденту

- Наличие высшего образования, степень магистра по направлению «нанотехнология и микросистемная техника»;
- Наличие ученой степени кандидата физико-математических наук;
- Знания в области физики полупроводников;
- Опыт научно-исследовательской работы не менее 4 лет;

- Опыт участия в грантах РНФ в качестве исполнителя;
- Опыт участия в грантах КНВШ;
- Наличие не менее 12 публикаций в рецензируемых научных журналах, индексируемых базами данных Scopus или РИНЦ;
- -Наличие зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности (патенты, изобретения, полезные модели, программы для ЭВМ и ноу-хау);
- -Опыт руководства НИР студентов магистратуры.

Конкретные обязанности будут определяться исходя из квалификации соискателя.

- ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 40800 руб.
- CTABKA: 1.0
- Срок трудового договора 5 лет

К заявлению об участии в конкурсе должны прилагаться следующие документы

- копии документов о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о присуждении учёной степени, присвоении учёного звания (при наличии);
- сведения о научной работе за пять лет, предшествовавших дате объявления конкурса, список публикаций;

Документы следует направлять по адресу: 194021, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 26, учёному секретарю ФТИ им. А.Ф. Иоффе М.И. Патрову, телефон для справок: (812) 297 22 45